

採用超微型 DFN0.6X0.6 封裝並配備散熱焊盤 高效能 20V N 通道 MOSFET 實現卓越散熱與空間節省！

美國加州聖荷西，2026 年 4 月 30 日 —Analog Power 今日發表高效率 20V N 通道功率 MOSFET AMPMH600UNE。此元件採用超緊湊 DFN0.6X0.6-3EP 封裝，具備 600mΩ 典型 RDS(on)；藉由創新的散熱焊盤 (Exposed Pad) 設計，能在極微小的電路板空間內展現卓越的散熱潛能，為空間受限及電池供電的電子產品提供高度可靠、低電阻的切換解決方案。

AMPMH600UNE 透過在業界標準微型封裝中整合 20V 耐壓與散熱焊盤，在成功協助設計人員在兼顧優異熱管理的同時，大幅釋放電路板佈局彈性。此技術突破不僅顯著簡化了高密度電路設計，更比傳統大型封裝替代方案大幅縮減了電源路由與負載切換所需的整體佔地面積。

本元件的主要特色包括：

- 20V N 通道功率 MOSFET，實現高效的低電壓電源調節
- 典型 RDS(on) = 600mΩ，有效降低導通損耗並最大化提升整體系統效率
- 搭載散熱焊盤的超微型 DFN0.6X0.6-3EP 封裝，兼顧散熱與高效佈局
- 低臨界電壓 (Low threshold voltage)，完美適用於直接邏輯電平閘極驅動
- 堅固的半導體設計，在嚴苛的高密度環境下提供高可靠度與長期穩定性

典型應用：

- 超輕薄可攜式電子產品 (如手機、穿戴裝置) 的高側負載切換
- 電池管理系統 (BMS) 與手持式裝置的電源路由
- 高效率、低剖面 (low-profile) 的 DC/DC 轉換模組
- 訊號閘控與小訊號切換電路
- 空間受限的 IoT 感測器與嵌入式硬體



Analog Power 的 600mΩ、20V DFN0.6x0.6-3EP 封裝 N 通道 MOSFET 現已開放樣品申請，並支援量產供貨。產品數據資料表請至下列網址下載：

<https://www.analogpowerinc.com/datasheet.php?part=AMPMH600UNE>

如需更多資訊，請造訪：www.analogpowerinc.com。

關於 Analog Power：Analog Power 成立於 2002 年，總部位於美國加州聖荷西，為功率 MOSFET 的領先製造商。公司提供完整的 N 通道與 P 通道 MOSFET 產品線，電壓範圍涵蓋 20V 至 1.5kV，並提供可協助終端產品小型化、提升效能的特定應用 MOSFET。透過與一級晶圓代工廠及封裝測試外包夥伴合作，Analog Power 在維持市場領先等級的品質與可靠度之餘，仍保有靈活、以客戶需求為導向的服務精神。



聯絡資訊

Analog Power Inc

台北市內湖區洲子街 58 號 1 樓A7

郵遞區號：114064

<https://www.analogpowerinc.com/contactus.html>